

EVM User's Guide: TPSI2260Q1EVM

TPSI2260-Q1 评估模块



说明

TPSI2260Q1EVM 是包含多个测试点和跳线的硬件评估模块 (EVM)，用于全面评估器件的性能和功能。该评估模块包含测试和评估 TPSI2260-Q1 所需的一切资源，之后就可以集成到更大型应用的电源系统设计中。TPSI2260Q1EVM 可单独使用，也可选择与外部微控制器配对使用，用于驱动器件的使能信号。使用该 EVM 可以评估诸如电介质耐压测试（又称高压 [HiPot] 测试）和直流快充浪涌电流等应用需求，且无需外部保护元件。此 EVM 组装了采用 SOIC 封装的 TPSI2260-Q1。

特性

此 EVM 具有以下特性：

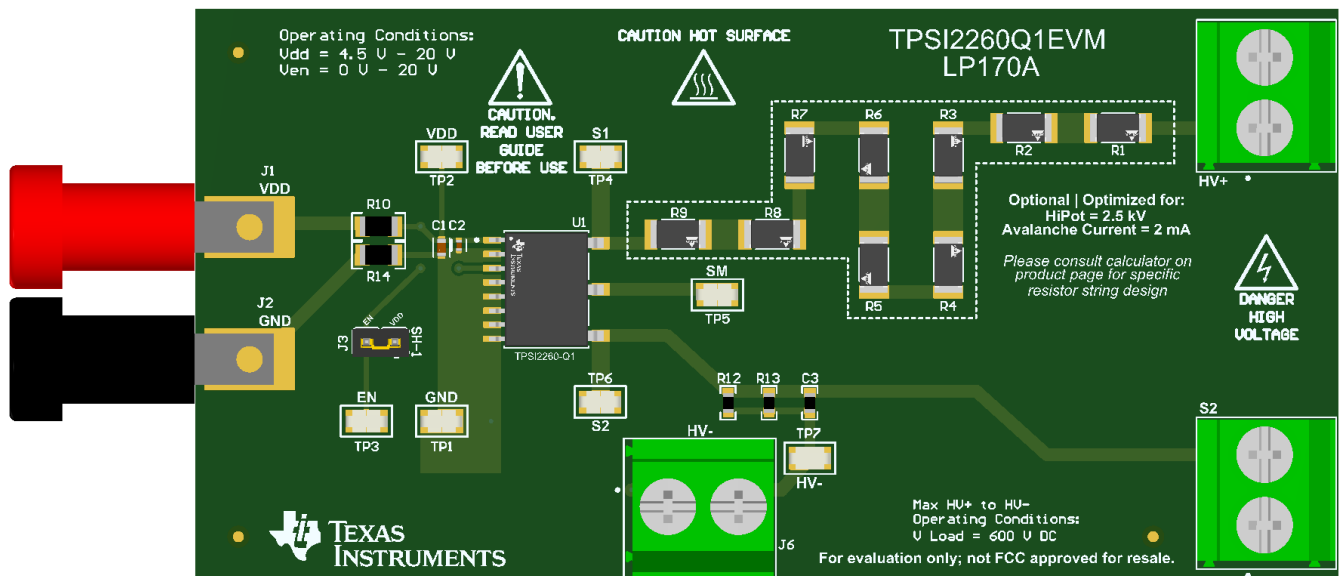
- 初级侧工作电压：4.5V – 20V
- 具备高达 2.5kV 的高电势 (HiPot) 耐压测试能力
- 终端块连接器可轻松实现有线连接
- 每个引脚和电压电源都有测试点，以确保正常运行

应用

- [HEV/EV 绝缘电阻监测](#)
- [混合动力、电动和动力传动系统](#)
- [电池管理系统 \(BMS\)](#)
- [太阳能](#)
- [车载充电器](#)
- [电动汽车充电基础设施](#)

备注

免责声明：请参阅 TPSI2260-Q1 产品页面上的数据表和设计资源，以优化元件选择并满足所需应用的 HiPot 电压和雪崩电流要求。



1 评估模块概述

1.1 简介

TPSI2260-Q1 是一款隔离式固态继电器，专为高电压汽车和工业应用而设计。TPSI2260-Q1 集成了德州仪器 (TI) 的电容隔离技术，不会受到机械磨损和光退化等常见故障模式的影响，从而无缝取代机械继电器和光继电器。该器件的整个初级侧仅需要 5mA 的输入电流，并集成了一个失效防护 EN 引脚，可防止对 VDD 电源反向供电的任何可能性。次级侧包含背对背 MOSFET，从 S1 至 S2 的关断电压为 600V。TPSI2260-Q1 具有雪崩性能稳健的 MOSFET 并且采用的 11 引脚 DWQ 封装上的加宽引脚具有散热优势，使其可以承受高压 (HiPot) 筛选和直流快速充电器浪涌电流，前提是为该应用选择了合适的元件。TPSI2260Q1EVM 可帮助设计人员评估增强型隔离等级高达 5kVrms 的 TPSI2260-Q1 隔离式开关的运行情况和性能。电路板的输入和输出连接是端子块，可轻松实现有线连接。本 EVM 用户指南介绍了该 EVM 的连接、测试点描述、工作模式、原理图、物料清单和电路板布局布线。

1.2 套件内容

表 1-1. 套件内容

条目	数量
TPSI2260Q1EVM	1

1.3 规格

本节总结了默认配置中 TPSI2260Q1EVM 的性能规格。请参阅 *建议的测试设置*，了解测试期间典型电压建议值。

表 1-2. TPSI2260Q1EVM 输入电压限制

参数		最小值	典型值	最大值	单位
V _{VDD}	初级侧电源电压	4.5	-	20	V
V _{EN}	使能电压	0	-	20	V
V _{HV+}	次级侧额定高电压输入	0	-	400	V
V _{HiPot}	次级侧高电势耐受电压 (60s 脉冲)	0	-	2500	V

1.4 器件信息

表 1-3. TPSI2260-Q1 器件规格

器件规格	值
初级侧电源电流	9mA 开启状态、1 μ A 关闭状态
集成雪崩额定 MOSFET 的关断电压	600V
隔离栅额定值	5000V _{RMS}
汽车认证	AEC-Q100
封装	DWQ (SOIC、11) 10.3mm $\times$ 7.5mm (标称值)

通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EVM) 用户安全指南



务必遵循 TI 的设置和应用说明，包括在建议的电气额定电压和功率限制范围内使用所有接口元件。务必采取电气安全防护措施，这样有助于确保自身和周围人员的人身安全。如需了解更多信息，请联系 TI 的产品信息中心，网址为 <http://ti.com/customer support>。

保存所有警告和说明以供将来参考。

警告

务必遵循警告和说明，否则可能引发电击和灼伤危险，进而造成财产损失或人员伤亡。

TI HV EVM 一词是指通常以开放式框架、敞开式印刷电路板装配形式提供的电子器件。该器件严格用于开发实验室环境，仅供了解开发和应用高压电路相关电气安全风险且接受过专门培训、具有专业知识背景的合格专业用户使用。德州仪器 (TI) 严禁任何其他不合规的使用和/或应用。如果不满足合格要求，应立即停止进一步使用 HV EVM。

1. 工作区安全：

- 保持工作区整洁有序。
- 每次电路通电时，都必须由具有资质的观察员在场监督。
- TI HV EVM 及接口电子元件通电区域必须设有有效的防护栏和标识；指示可能存在高压操作，以避免意外接触。
- 开发环境中使用的所有接口电路、电源、评估模块、仪器、仪表、示波器和其他相关装置如果超过 50Vrms/75VDC，则必须置于紧急断电 EPO 保护电源板内。
- 使用稳定且不导电的工作台。
- 使用充分绝缘的夹钳和导线来连接测量探针和仪器。尽量不要徒手进行测试。

2. 电气安全：

- 作为一项预防措施，假定整个 EVM 可能存在用户可完全接触到的高电压是一种好的工程做法。
- 执行任何电气测量或其他诊断测量之前，需切断 TI HV EVM 及其全部输入、输出和电气负载的电源。再次确认 TI HV EVM 已安全断电。
- 确认 EVM 断电后，根据所需的电路配置、接线、测量设备连接和其他应用需求执行进一步操作，同时仍假定 EVM 电路和测量仪器均带电。
- EVM 准备就绪后，根据需要将 EVM 通电。

警告

EVM 通电后，请勿触摸 EVM 或电路，因为 EVM 或电路可能存在高压，会造成电击危险。

3. 人身安全

- 穿戴个人防护装备（例如乳胶手套或具有侧护板的安全眼镜）或将 EVM 放置于带有联锁装置的透明塑料箱，避免意外接触。

安全使用限制条件：

勿将 EVM 作为整体或部分生产单元使用。

2 硬件

2.1 建议测试设备

建议使用以下设备测试 TPSI2260Q1EVM：

- 用于输入的可调节电源
- 示波器
- 数字万用表
- 可选：用于切换 TPSI2260-Q1 使能 (EN) 引脚的函数发生器或微控制器

2.2 跳线信息

表 2-1. 输入和输出连接器说明

连接器	标签	说明
J1	VDD	初级侧电源
J2	GND	初级侧 GND
J3	SH-1	闭合时将 EN 引脚连接至 VDD 的跳线
J4	HV+	次级侧正输入
J5	S2	电压检测输出
J6	HV-	次级侧负输入

2.3 测试点

表 2-2. 测试点和跳线说明

测试点、跳线	标签	说明
TP1	GND	初级侧 GND 测试点
TP2	VDD	初级侧电源测试点
TP3	EN	启用引脚测试点
TP4	S1	电阻器链后的次级侧 HV+ 电压
TP5	SM	热引脚
TP6	S2	电压检测输出测试点
TP7	HV-	HV - 次级侧测试点

3 实现结果

3.1 评估设置

3.1.1 建议的测试设置

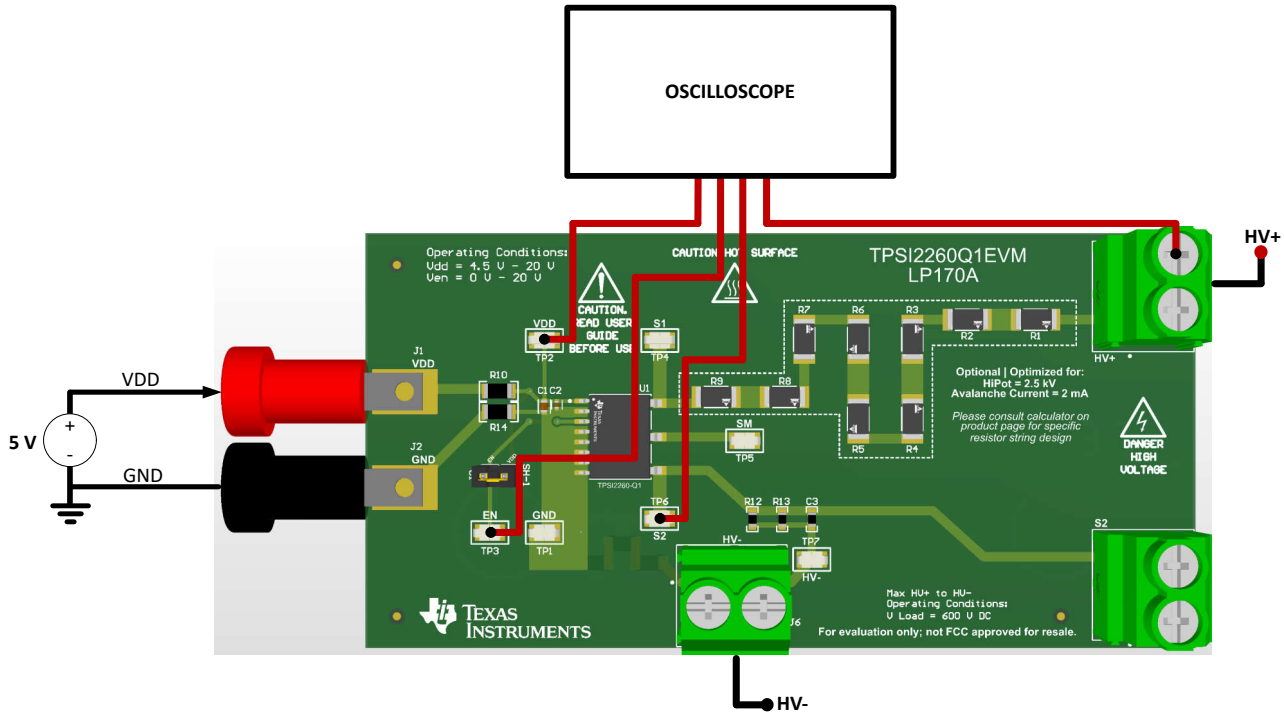


图 3-1. TPSI2260Q1EVM 测试设置

备注

重要说明： 图 3-1 中所示的设置假设高压和低压接地 (GND 和 HV-) 短路，以便能够安全地捕获示波器。在此配置中，绕过 TPSI2260-Q1 器件中的隔离栅。要评估具有隔离栅的器件，请使用差分示波器探头并保持高电压和低电压接地分离。

验证 TPSI2260Q1EVM 具有以下跳线设置：

1. **J3** - 将 EN 引脚连接到 VDD 电源轨

要测试 TPSI2260-Q1 是否正常运行，请按照以下步骤操作：

1. 将 5V 电源连接到 **J1** 的香蕉插孔，并将负极引线连接到 **J2**，从而为 TPSI2260-Q1 供电。
2. 在放入外壳或连接高压 (HV) 电源之前，请使用以 **TP1 (GND)** 为基准的 **TP2 (VDD)** 和 **TP3 (EN)** 验证 TPSI2260-Q1 初级侧的所有电压是否符合预期。
3. 将电路板放置在外壳中，将高压电源 (400V) 正极引线连接到 **J4**，将负极引线连接到 **J6**。
4. 将示波器探头连接到相关电压 (VDD/EN、HV+、S2) 后，打开高压电源，然后切换连接到 EN 的 5V 电源，观察 **TP3 (EN)**、**J4 (HV+)** 和 **TP6 (S2)** 是否显示预期电压

要测试 TPSI2260-Q1 的高电势 (HiPot) 是否正常运行，请按照以下步骤操作：

1. 在 HiPot 测试期间，验证是否没有电源连接到 TPSI2260-Q1 **J1** 和 **J2** 初级侧连接器。
2. 将电路板放置在外壳中，将高压电源 (2500V) 正极引线连接到 **J4**，将负极引线连接到 **J6**。

- 将示波器探头连接到相关电压 (HV+、S1-S2) 并使用 60s 脉冲打开高压电源，然后观察 **J4** (HV+)、**TP4-TP6** (S1-S2) 是否显示预期的电压。

3.2 性能数据和结果

3.2.1 波形

完成[建议的测试设置](#)后，验证 [图 3-2](#) 中的波形中是否显示了以下通道。

- CH 1 = VDD/EN
- CH 2 = HV+
- CH 3 = S2

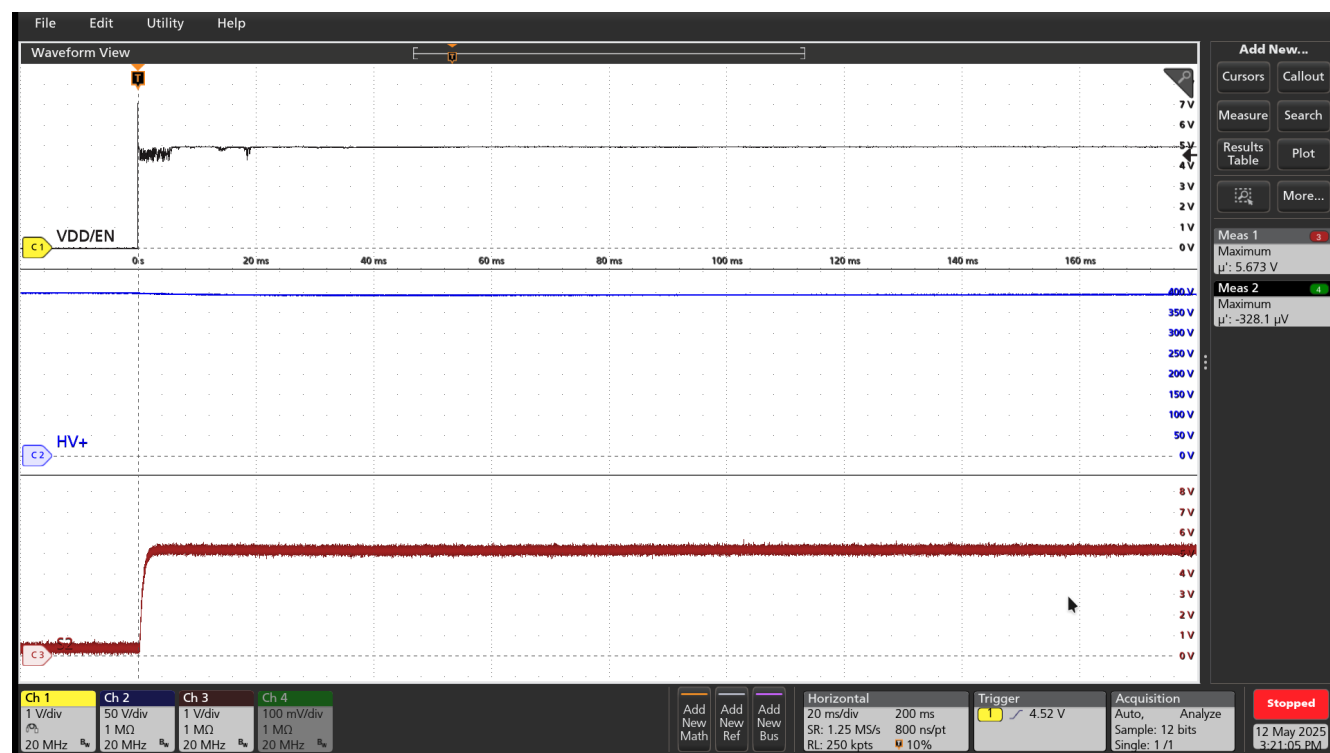


图 3-2. HV = 400V (EN = 5V) 时的电压检测输出 (S2) 测试点

[图 3-3](#) 显示了使用以下通道设置的两个测试点。

- CH 1 = VHipot (HV+)
- CH 2 = S1-S2

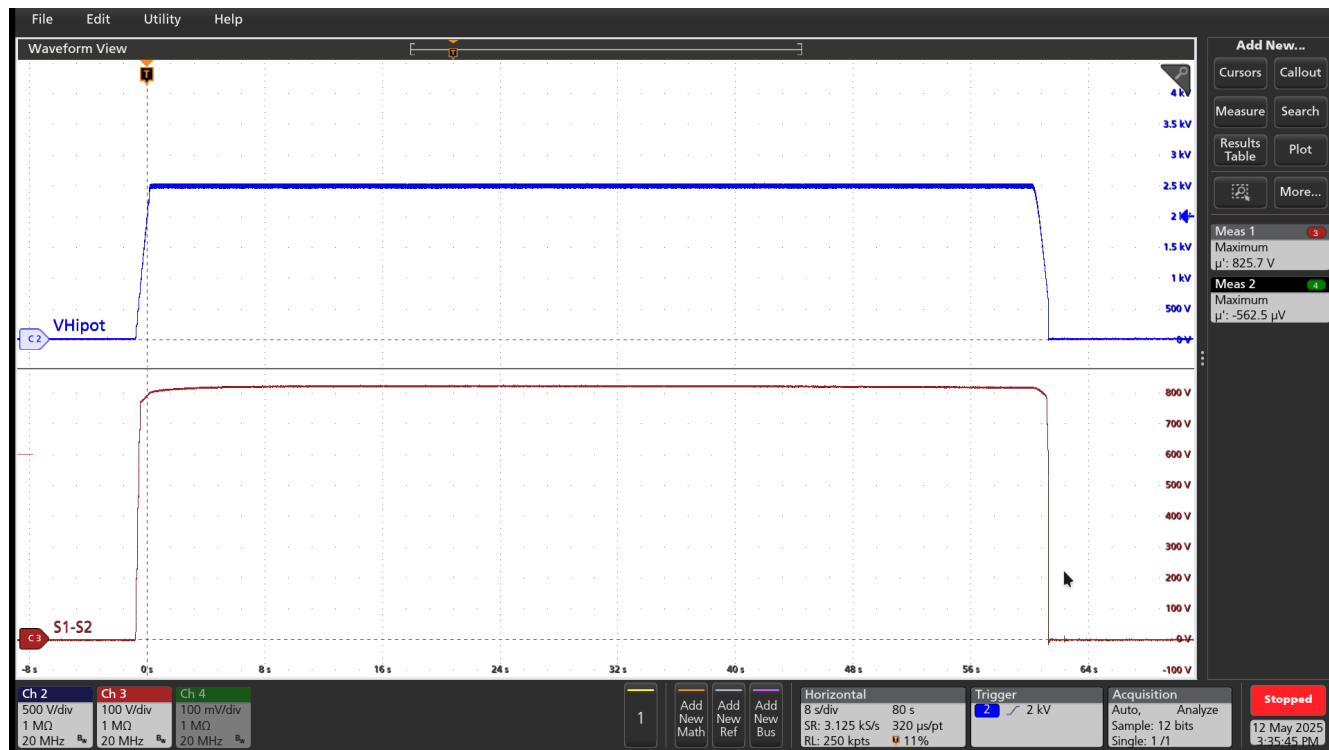


图 3-3. HV = 2,500V (EN = 5V) 时的次级检测 (S1) 和电压检测 (S2) 测试点

3.2.2 S2 分压器

电压检测输出测试点 S2 (TP6) 用于测量分压器。测量的电压值取决于并联电阻器 R12 和 R13 以及电阻器网络 R1-R9。可使用以下公式计算电压测量：

$$V_{S2} = \frac{R12 || R13}{(R1 + R2 + \dots + R9) + (R12 || R13)} \times V_{HV} \quad (1)$$

4 硬件设计文件

4.1 原理图

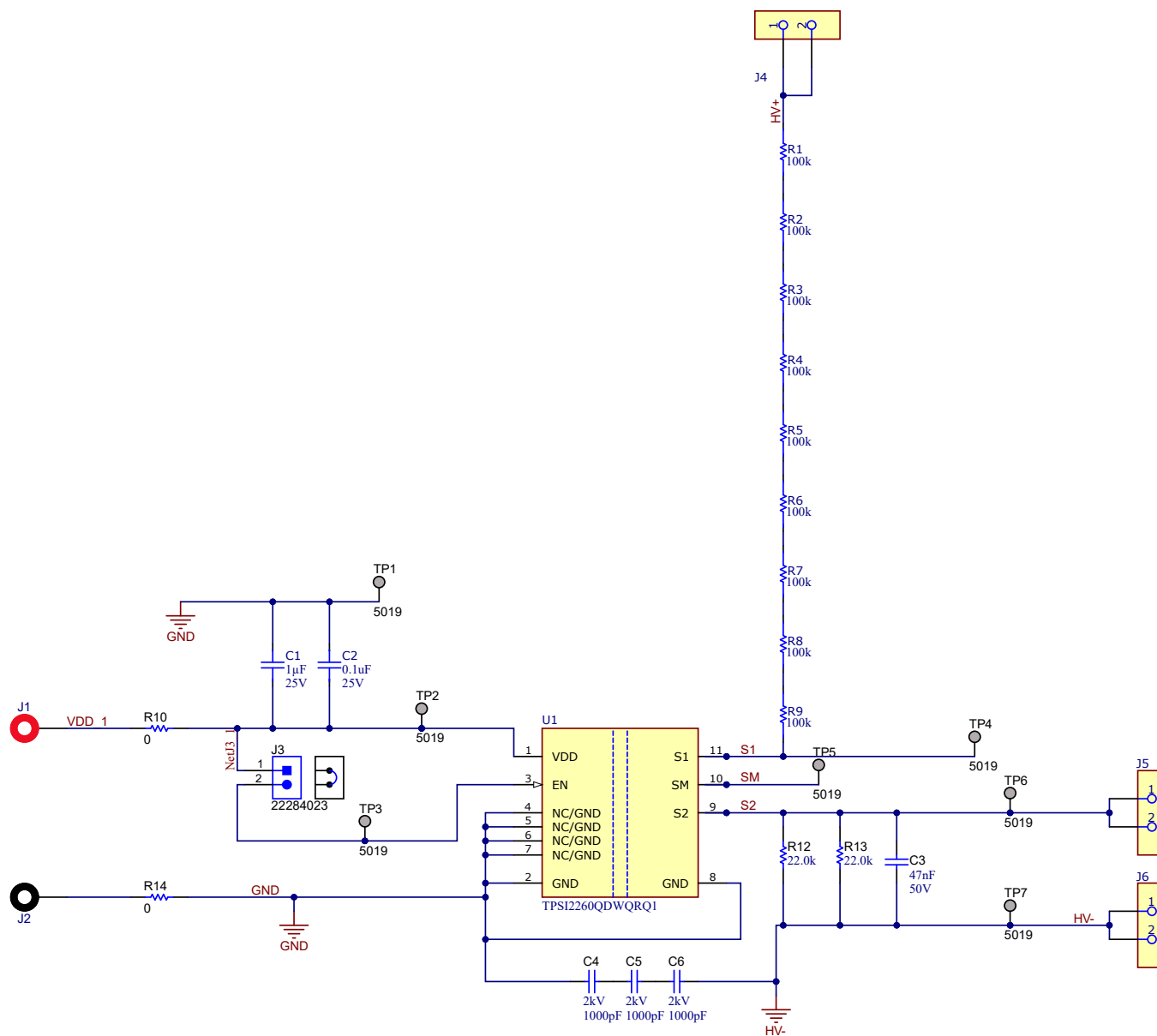


图 4-1. TPSI2260-Q1EVM 原理图

4.2 PCB 布局

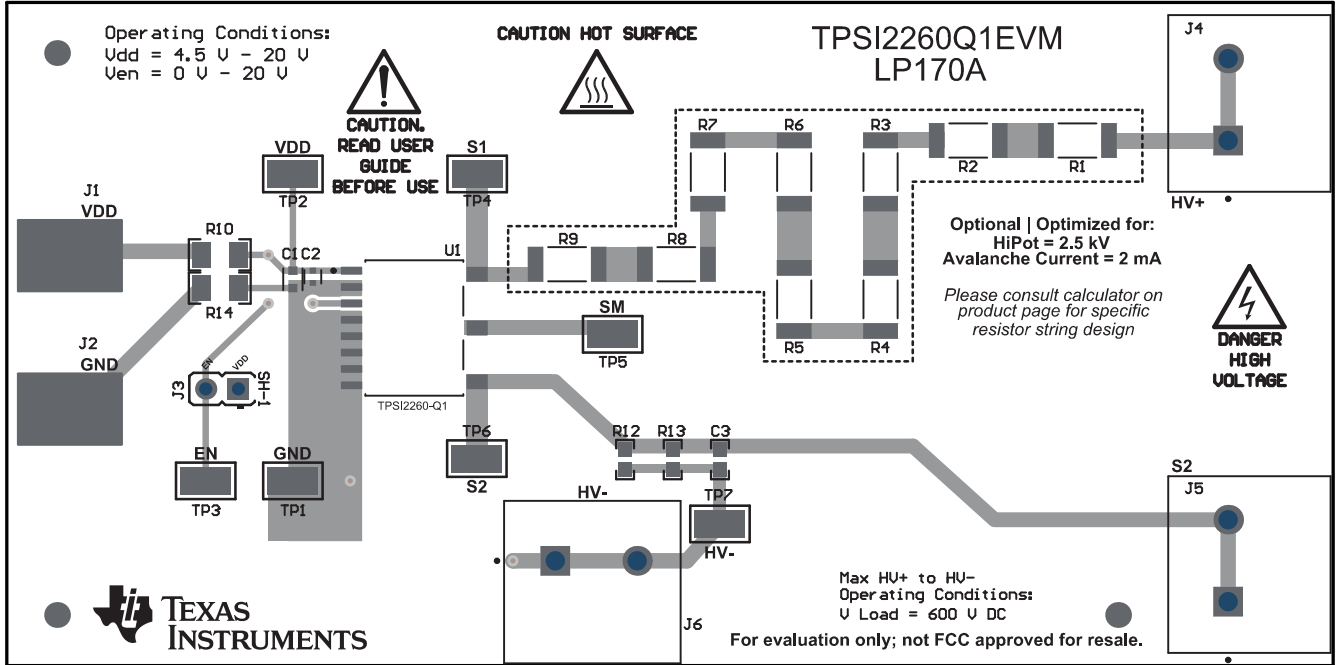


图 4-2. TPSI2260-Q1 EVM - 复合视图

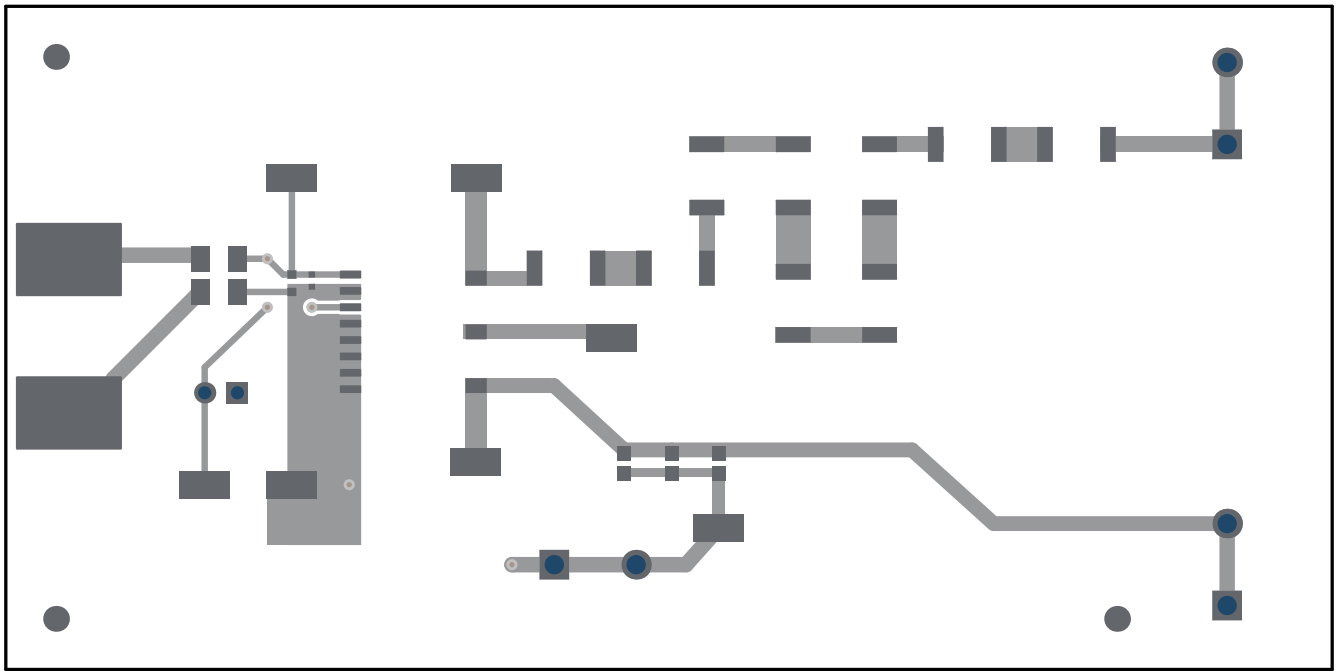


图 4-3. TPSI2260-Q1 EVM - 第 1 层



图 4-4. TPSI2260-Q1 EVM - 第 2 层

4.3 物料清单 (BOM)

位号	数量	值	说明	封装参考	器件型号	制造商
!PCB1	1		印刷电路板		LP170	不限
C1	1	1 μ F	汽车级陶瓷电容器, 1 μ F, $\pm$ 10%, 25VDC, X7R, 0603, 纸质 T/R	0603	GCM188R71E105KA64J	Murata
C2	1	100nF	陶瓷电容器汽车级 0.1 μ F $\pm$ 10% 25V X7R 0402	0402	TMK105B7104KVHF	Taiyo Yuden
C3	1	0.047 μ F	电容, 陶瓷, 0.047 μ F, 50V, $\pm$ 10%, X7R, 0603	0603	C1608X7R1H473K080AA	TDK
C4、C5、C6	3	1000pF	电容, 陶瓷, 1000pF, 2000V, $\pm$ 10%, X7R, AEC-Q200 1 级, 1206	1206	C1206C102KGRACAUTO	Kemet
H1、H2、H3、H4	4		Bumpon, 半球形, 0.44 $\times$ 0.20, 透明	透明 Bumpon	SJ-5303 (CLEAR)	3M
J1	1		香蕉插头, 红色绝缘尼龙, TH	香蕉插头, 红色绝缘尼龙, TH	108-0902-001	Cinch Connectivity
J2	1		香蕉插头, 黑色绝缘尼龙, TH	香蕉插头, 黑色绝缘尼龙, TH	108-0903-001	Cinch Connectivity
J3	1		接头, 2.54mm, 2x1, 锡, TH	接头, 2.54mm, 2x1, TH	22284023	Molex
J4、J5、J6	3			CONN_TERM_BLOCK2	6.91251E+11	Würth Electronics
R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9	9	100k	电阻厚膜, 100k Ω , 1%, 1W, 100ppm/ $^{\circ}$ C, 2010	2010	CRCW2010100KFKEFHP	Vishay Dale
R10、R14	2	0	电阻, 0, 5%, 0.25W, 1206	1206	RC1206JR-070RL	Yageo America
R12、R13	2	22.0k	电阻, 22.0k, 1%, 0.1W, 0603	0603	RC0603FR-0722KL	Yageo
SH-1	1	1x2	分流器, 100mil, 镀金, 黑色	分流器	SNT-100-BK-G	Samtec
TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7	7		测试点, 微型, SMT	测试点, 微型, SMT	5019	Keystone
U1	1		具有热雪崩保护功能的汽车级 600V、50mA 隔离开关	SOIC11	TPSI2260QDWQRQ1	德州仪器 (TI)

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
版权所有 © 2025，德州仪器 (TI) 公司